

2SB896, 2SB896A

シリコン PNP プレーナ形 / Si PNP Planar

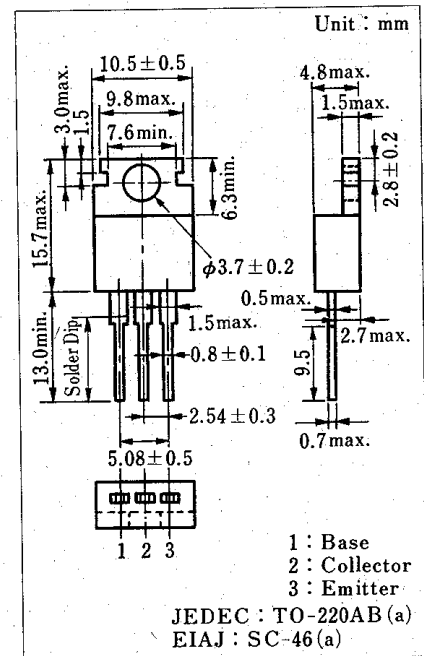
低電圧スイッチング用 / Low Voltage Switching

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-40	V
2SB896A		-50	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-20	V
2SB896A		-40	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-15	A
コレクタ電流	I_C	-10	A
コレクタ損失 (Tc=25 °C)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	2SB896	$V_{CB} = -40 V, I_E = 0$			-50	μA
	2SB896A	$V_{CB} = -50 V, I_E = 0$			-50	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5 V, I_C = 0$			-50	μA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SB896	$I_C = -10 mA, I_B = 0$	-20			V
	2SB896A		-40			
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -2 V, I_C = -0.1 A$	45			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = -2 V, I_C = -2 A$	60		260	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -7 A, I_B = -0.23 A$			-0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -7 A, I_B = -0.23 A$			-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10 V, I_C = -0.5 A$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 V, I_E = 0, f = 1 MHz$		200		pF
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -2 A, I_{B1} = -66 mA, I_{B2} = 66 mA$		0.1		μs
蓄積時間	t_{stg}			0.5		μs
下降時間	t_f			0.1		μs

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	60 ~ 120	90 ~ 180	130 ~ 260